

04:12

Зависимость кинетики распада плазмы низковольтного цезий-водородного разряда от материала электродов

© А.Г. Никитин, С.М. Школьник

Физико-технический институт им. А.Ф.Иоффе РАН,
194021 Санкт-Петербург, Россия

(Поступило в Редакцию 1 декабря 1995 г.)

1. Выполненные некоторое время назад расчеты [1,2] показали, что в низковольтном (НВ) разряде в смеси цезия с водородом ($\text{Cs}-\text{H}_2$) могут быть реализованы условия для создания в объеме высокой концентрации отрицательных ионов водорода (H^-). Это открывает перспективу использования такого разряда для создания эффективных источников H^- . Основным механизмом образования H^- является диссоциативное прилипание электронов к колебательно-возбужденным молекулам водорода H_2^* [3]. Оптимальные для диссоциативного прилипания значения электронной температуры $T_e \sim 1 \text{ эВ}$ [4].

Первые экспериментальные исследования, выполненные в диоде с подогревным катодом и плоскопараллельной геометрией электродов, подтвердили возможность получения в НВ $\text{Cs}-\text{H}_2$ разряде плазмы с параметрами, необходимыми для генерации H^- и, в частности, нужного уровня температуры электронов [5,6]. Измерения колебательной функции распределения молекул H_2^* в разряде представляют большие трудности и не осуществлены до настоящего времени. Поэтому весьма интересны эксперименты, в которых возможно наблюдение эффектов, связанных с наличием H_2^* в НВ $\text{Cs}-\text{H}_2$ разряде.

2. Один из таких эффектов был обнаружен при исследовании послесвечения разряда [7]. В течение длительного времени после выключения тока в межэлектродном промежутке сохраняется плазма достаточно высокой концентрации с холодными электронами (рис. 1; на всех рисунках $t = 0$ в момент выключения тока). Из результатов, приведенных на рис. 1,а, следует, что независимо от уровня T_e в разряде за время $t \geq 10^{-5} \text{ с}$ после отключения тока T_e падает до величин, близких к величине температуры эмиттера. Наблюдаемый уровень концентрации плазмы в послесвечении, очевидно, не может поддерживаться за счет ионизации атомов Cs столь холодными электронами. Эксперименты показывают, что концентрация в послесвечении, которая в отличие от температуры определяется именно параметрами разряда, сильно зависит от T_e разрядной плазмы (рис. 1,б). Существование плазмы в послесвечении поддерживается объемной ионизацией атомов Cs долгоживущими колебательно-возбужденными молекулами водорода [7] аналогично тому, что имеет место в смеси азота с щелочными металлами [8]. На

температуру электронов в послесвечении наличие в объеме H_2^* практически не влияет. В некоторых режимах наблюдалось лишь незначительное повышение T_e на поздних стадиях послесвечения (например, 1 на рис. 1,а).

Исследования также показали [7,9], что параметрами, сильно влияющими на концентрацию плазмы в послесвечении, являются давление водорода p_{H_2} и длительность разрядного импульса τ . Настоящая работа посвящена описанию обнаруженной в последнее время сильной зависимости картины послесвечения от материала электродов.

3. Эксперименты по исследованию распада плазмы НВ $\text{Cs}-\text{H}_2$ разряда проводились в двух полностью аналогичных по конструкции приборах. Здесь укажем лишь основные характеристики; подробное описание конструкции прибора, экспериментальной установки и техники измерений можно найти в [5].

Приборы представляли из себя смонтированные в стеклянной колбе диоды с плоскопараллельной геометрией электродов (торцы цилиндров диаметром 12 мм, боковая поверхность которых была защищена керамикой BeO). Катод с косвенным подогревом. Сквозь отверстие в центре анода вводился цилиндрический зонд диаметром 0.1 мм и длиной 2 мм, ориентированный параллельно электродам. Межэлектродный промежуток $L = 3 \text{ мм}$. Зонд располагался вблизи центра межэлектродного промежутка. В первом приборе катод был изготовлен из платины, а анод — из никеля (Pt-Ni). Во втором приборе катод — монокристалл вольфрама (грань [110]), анод — медь $M1$ (W-Cu). Разряд питался прямоугольными импульсами тока варьируемой длительности ($\tau \leq 2 \text{ мс}$). Были приняты меры для быстрого гашения разряда (длительность заднего фронта не превышала 5 мкс). Частота следования импульсов составляла 10–25 Гц.

Исследованный диапазон параметров: напряжение разряда $U \leq 8 \text{ В}$, ток разряда $I \leq 5 \text{ А}$, температура катода $850 \leq T_k \leq 1250 \text{ К}$, давление водорода $0.1 \leq p_{\text{H}_2} \leq 5 \text{ Тор}$, концентрация атомов цезия $5 \cdot 10^{13} \leq N_{\text{Cs}} \leq 3 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$. Напряжение, при котором поджигался разряд U_n , зависело от N_{Cs} , p_{H_2} и T_k . Характерное значение $U_n \approx 3-5 \text{ В}$. При увеличении напряжения U до $U - U_n \geq 1 \text{ В}$, в большинстве режимов вольт-амперная характеристика насыщалась.

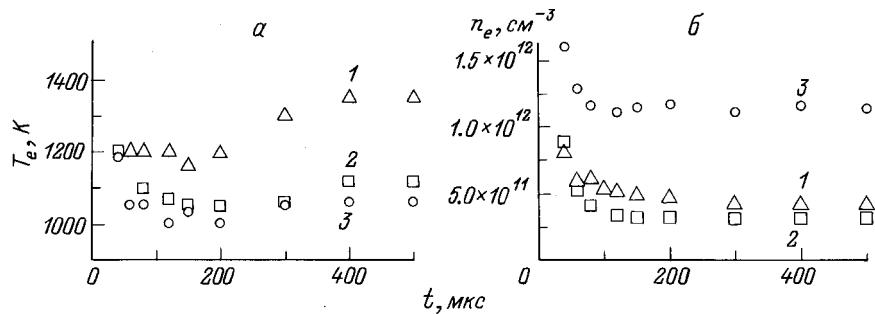


Рис. 1. Зависимость температуры (*а*) и концентрации электронов (*б*) от времени в распадающейся плазме. Катод — платина, анод — никель. $p_{\text{H}_2} = 0.5$ Тор, длительность разрядного импульса $\tau = 500$ мкс. Параметры разряда: 1 — $N_{\text{Cs}} \approx 1.7 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $T_k = 1230 \text{ K}$, $U = 3.9 \text{ В}$, $I = 1.0 \text{ А}$, $n_e = 2.3 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_{e0} = 7000 \text{ K}$; 2 — $N_{\text{Cs}} \approx 1.7 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $T_k = 1160 \text{ K}$, $U = 3.5 \text{ В}$, $I = 0.9 \text{ А}$, $n_e = 2.1 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_{e0} = 6300 \text{ K}$; 3 — $N_{\text{Cs}} \approx 1.7 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $T_k = 1160 \text{ K}$, $U = 6.1 \text{ В}$, $I = 2.0 \text{ А}$, $n_e = 2.9 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_{e0} = 7600 \text{ K}$.

4. Характерный результат сравнения кривых распада плазмы NB Cs—H₂ разряда в приборах с электродами из различных материалов приведен на рис. 2. Для корректного анализа влияния материала электродов на кинетику послесвечения были подобраны режимы, соответствующие примерно одинаковым условиям в разряде: одни и те же давления водорода и длительности разрядного импульса, близкие значения электронной температуры и концентрации.

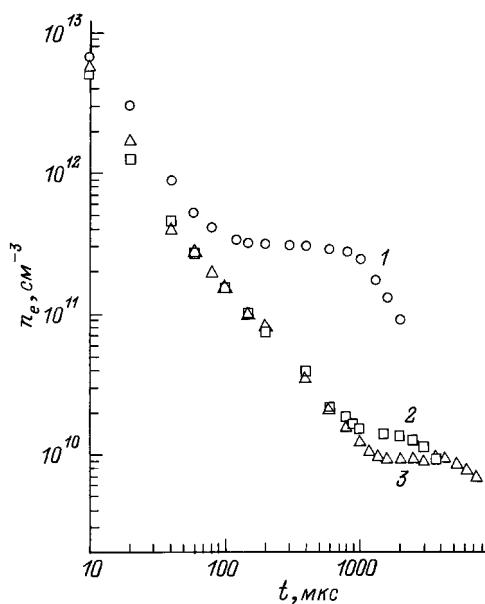


Рис. 2. Зависимость концентрации электронов от времени в распадающейся плазме. $p_{\text{H}_2} = 0.5$ Тор, $\tau = 500$ мкс; 1 — катод — платина, анод — никель, $N_{\text{Cs}} \approx 1.7 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $T_k = 1160 \text{ K}$, $U = 4 \text{ В}$, $I = 0.9 \text{ А}$, $n_e = 2.1 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_{e0} = 6300 \text{ K}$; 2 — катод — вольфрам, анод — медь, $N_{\text{Cs}} \approx 2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $T_k = 1170 \text{ K}$, $U = 7.8 \text{ В}$, $I = 1.1 \text{ А}$, $n_e = 5.3 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_{e0} = 6600 \text{ K}$; 3 — катод — вольфрам, анод — медь, $N_{\text{Cs}} \approx 2 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $T_k = 1150 \text{ K}$, $U = 5.5 \text{ В}$, $I = 1.2 \text{ А}$, $n_e = 5.1 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_{e0} = 6500 \text{ K}$.

Видно, что в обоих приборах распад разрядной плазмы, поначалу определяемый объемной трехчастичной рекомбинацией ионов Cs⁺ с остывшими электронами и деионизацией на электродах, постепенно замедляется. На кривых появляется достаточно выраженное "плато". Это может быть объяснено лишь наличием источника ионообразования, интенсивность которого определяет уровень плато. Как указано выше, ионизация атомов Cs происходит за счет энергии присутствующих в объеме колебательно-возбужденных молекул водорода. Результаты, приведенные на рис. 2, показывают, что эффективность источника ионообразования сильно зависит от материала электродов: концентрация плазмы на "плато" при прочих равных условиях изменяется более, чем на порядок величины.

5. Детальное исследование распада плазмы разряда с электродами (W—Cu) показало, что хотя концентрация долгоживущей плазмы в сопоставимых режимах значительно ниже, основные закономерности, обнаруженные при изучении распада с электродами (Pt—Ni) [7,9], сохраняются.

В экспериментах с электродами (Pt—Ni) на кривых $n_e(t)$ был зарегистрирован подъем плато с уменьшением давления водорода. Зависимость от давления водорода, обнаруженная при исследовании разряда с электродами (W—Cu), показана на рис. 3. Видно, что имеет место та же закономерность — увеличения концентрации плазмы в послесвечении с уменьшением p_{H_2} .

На рис. 4 представлены зависимости уровня плато в разрядах с электродами из различных материалов от длительности разрядного импульса. Концентрация плазмы в послесвечении в обоих случаях вначале значительно возрастает при увеличении τ . Затем наблюдается тенденция к насыщению. Характерное значение τ , необходимое для установления квазистационарной картины распада, $\tau^* \sim 1$ мс.

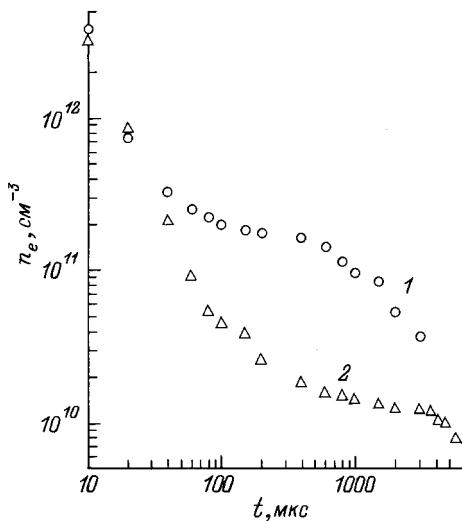


Рис. 3. Зависимость концентрации электронов от времени в распадающейся плазме. Катод — вольфрам, анод — медь, $\tau = 1.5 \text{ мс}$; 1 — $p_{\text{H}_2} = 0.2 \text{ Тор}$, $N_{\text{Cs}} \approx 1.5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $T_k = 1000 \text{ K}$, $U = 4 \text{ В}$, $I = 0.7 \text{ А}$, $n_e = 2.8 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_{e0} = 5500 \text{ K}$; 2 — $p_{\text{H}_2} = 2 \text{ Тор}$, $N_{\text{Cs}} \approx 1.5 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $T_k = 1000 \text{ K}$, $U = 6.6 \text{ В}$, $I = 1.5 \text{ А}$, $n_e = 2.0 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_{e0} = 5600 \text{ K}$.

6. Полученные результаты показали, что материал электродов оказывает значительное влияние на процессы в послесвечении НВ Cs-H₂ разряда. Одной из причин столь существенного уменьшения концентрации плазмы в послесвечении при изменении материалов электродов может быть уменьшение

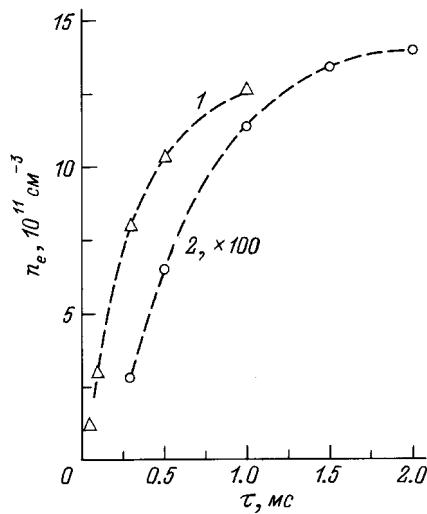


Рис. 4. Зависимость концентрации электронов на квазистационарной стадии распада от длительности разрядного импульса. $p_{\text{H}_2} = 0.5 \text{ Тор}$; 1 — платиновый катод и никелевый анод, $U = 5.8 \text{ В}$, $I = 3.7 \text{ А}$, $n_e = 2.3 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_{e0} = 7300 \text{ K}$, $N_{\text{Cs}} \approx 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $T_k = 1000 \text{ K}$; 2 — вольфрамовый катод и медный анод, $U = 5 \text{ В}$, $I = 0.6 \text{ А}$, $n_e = 4.5 \cdot 10^{13} \text{ см}^{-3}$, $T_{e0} = 5800 \text{ K}$, $N_{\text{Cs}} \approx 1.7 \cdot 10^{14} \text{ см}^{-3}$, $T_k = 1000 \text{ K}$.

коэффициента поверхностной рекомбинации атомов водорода в молекуле H₂. Это приводит к соответствующему увеличению степени диссоциации водорода в исходном разряде и в начале послесвечения и может вызвать значительное обеднение колебательной функции распределения молекул H₂ в области больших энергий (см., например, [10]). Эти вопросы потребуют дальнейшего исследования применительно к конкретным условиям низковольтного цезий-водородного разряда.

Авторы благодарны Ф.Г. Бакшту, В.Г. Иванову за полезные обсуждения и Б.И. Циркелю и А.Е. Богушевскому за помочь в работе.

Исследование, описанное в этой работе, стало возможно частично благодаря поддержке гранта № NTZ300 Международного научного фонда и Российского правительства, а также грантов Российского фонда фундаментальных исследований (№ 94-02-06370) и INTAS (№ 94-316).

Список литературы

- [1] Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г. // Письма в ЖТФ. 1986. Т. 12. Вып. 11. С. 672–675.
- [2] Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г. // ЖТФ. 1992. Т. 62. Вып. 2. С. 195–200.
- [3] Bacal M., Hamilton G.V. // Phys. Rev. Lett. 1979. Vol. 42. N 23. P. 1538.
- [4] Wadehra J.M. // Phys. Rev. A. 1984. Vol. 29. N 1. P. 106.
- [5] Бакшт Ф.Г., Дюжев Г.А., Елизаров Л.И. и др. // ЖТФ. 1992. Т. 62. Вып. 9. С. 148–152.
- [6] Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г., Костин А.А. и др. // ЖТФ. 1995. Т. 65. Вып. 8. С. 186–190.
- [7] Бакшт Ф.Г., Дюжев Г.А., Елизаров Л.И. и др. // Письма в ЖТФ. 1993. Т. 19. Вып. 22. С. 39–43.
- [8] Haug R., Reppenecker G., Schmidt C. // Chem. Phys. 1974. Vol. 5. N 2. С. 255–264.
- [9] Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г., Никитин А.Г., Школьник С.М. // Письма в ЖТФ. 1994. Т. 20. Вып. 22. С. 83–88.
- [10] Бакшт Ф.Г., Иванов В.Г. // ЖТФ. 1986. Т. 56. Вып. 8. С. 1562–1568.